1/9/1 DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02329934 PRODUCTION OF BASE MATERIAL FOR OPTICAL FIBER

PUB. NO.:

[JP 62246834 A]

PUBLISHED:

October 28, 1987 (19871028)

INVENTOR(s):

OMAE TOSHIKAZU HAYASHI TOKUJI TANAKA HIROYUKI

APPLICANT(s): MITSUBISHI CABLE IND LTD [000326] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: FILED:

61-089128 [JP 8689128] April 17, 1986 (19860417)

INTL CLASS:

[4] C03B-037/012; C03B-020/00; G02B-006/00

JAPIO CLASS:

13.3 (INORGANIC CHEMISTRY -- Ceramics Industry); 29.2

(PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD: RO12 (OPTICAL FIBERS)

JOURNAL:

Section: C, Section No. 489, Vol. 12, No. 128, Pg. 20, April

20, 1988 (19880420)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain a base material for optical fiber wherein a preform nearly free from scattering loss of light is produced by allowing denaturing treatment gas for the surface of glass to flow through the gap of a glass tube and a glass rod and also heating them at high temperature

CONSTITUTION: In such a case that a quartz glass tube is heated by a burner from the outside while being rotated and gas for forming the cladding is passed to the inside of the quartz glass tube and a cladding layer is formed on the inner surface thereof and thereafter a quartz glass rod is inserted and provided and both the glass tube and the glass rod are integrally fused to produce a base material for optical fiber, the following treatment is performed. Before the above-mentioned fusion into one body, denaturing treatment gas for the surface of glass is allowed to flow through the gap of the glass tube and the glass rod and also these are heated at high temperature and thereby the surfaces of the glass tube and the glass rod are subjected to denaturing treatment. Further, as the above-mentioned denaturing treatment gas for the surface of glass, gas containing ≥ 80 vol% chlorine is used.

⑩日本国特許庁(IP)

11)特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-246834

@Int_Cl.⁴

識別記号 庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月28日

C 03 B 37/012

A-8216-4G 7344-4G

20/00 // G 02 B 6/00

S-7370-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称

光ファイバ母材の製造方法

②特 願 昭61-89128

塑出 願 昭61(1986)4月17日

仰発 明 者 御 前

俊 和

伊丹市池尻4丁目3番地 大日日本電線株式会社伊丹工場

内

⑫発 明 者 林

徳 治

伊丹市池尻4丁目3番地 大日日本電線株式会社伊丹工場

内

砂発 明 者 田 中

紘 幸

伊丹市池尻4丁目3番地 大日日本電線株式会社伊丹工場

内

①出 願 人 三菱電線工

三菱電線工業株式会社

尼崎市東向島西之町8番地

致代 理 人 弁理士 朝日奈 宗太 外1名

明細書

方法。

1 発明の名称

光ファイバ母材の製造方法

2 特許請求の範囲

3 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光ファイバ母材の製造方法に関する。 さらに詳しくは、改良された石英系ガラスからなる光ファイバ母材のロッドインチューブ法 (以下、MRT 法という)による光ファイバ母材 の製造方法に関する。

[従来の技術]

一般に光ファイバの製造は、光ファイバ母材を製造し、これを加熱線引きするという工程を 怪ることにより行なわれており、光ファイバの 特性は線引き技術が不適切でない限り、光ファ イバ母材の特性によってほとんど決定される。

光ファイバ母材の製造方法としては、一般に内付け法、外付け法やロッドインチューブ法 (以下、RT法という)などが知られている。

近年、寸法精度が高く、研磨されたガラスロッドとガラスチューブとを単に融着一体化して

母材を製造することができ、大サイズの、しかも寸法精度の高い母材をうることが比較的容易であり、内付け法におけるようなコアの偏心、 専円度の低下などの問題が少ないなどの点から RT法が採用されてきている。

しかしながら、RT法によるばあいの 重大な難点は、光の吸収損失の原因となる OH基をコアとクラッドとの界面に含有されない母材を製造することが難かしく、このため内付け法によってえられるような低損失の光ファイバをうることが困難であるということにある。

そこで従来より RT法において、コアとクラッドとの界面に水蒸気が含有されない母材を製造するための研究がなされてきており、ある程度その改善がみられるようになってきている。

たとえば、特別昭 60-112635号公報には、コラブス中孔が水素および水素化合物をほぼ含まない乾燥した雰囲気にさらされるようにしてブリフォームのガラス管状母材の孔をコラブスする段階からなり、雰囲気は塩素および酸素から

本発明は石英系ガラスチューブ内面にクラッド形成ガスを通してクラッド層を形成し、サラスロッドをの間額にガカカラスロッドとの間額にガカカカラスロッドとの問題にが加速したのである。そして、本発明の光ファイムをとしたものである。そして、本発明の光ファイムによりによりにある。そして、本発明の光ファイムによりにある。そして、本発明の光ファイムによりにある。そして、本発明の光ファイムによりによりによりによりによりにある。

なる雰囲気であり、他の成分は10容量%以下であり、30~75容量%の範囲の塩素を含み、ドーピングされた石英コアを有し充実した断面を有するガラス光ファイバブリフォームの製造方法が記載されている。

[発明が解決しようとする問題点]

上記公報に記載されている製造方法は、雰囲気ガス中に含有される塩素濃度は30~75容量%であり、該塩素濃度が前記範囲外であるばあいには光の散乱損失が増大する難点がある。

そこで本発明者らは、上記のような従来のガラス光ファイバブリフォームの欠点である光の散乱損失が、ほとんどない光ファイバ母材を見出すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明に到達するに至った。

[問題点を解決するための手段]

すなわち本発明は、石英系ガラスチューブを回転させながら、外部よりパーナで加熱し、石 英系ガラスチューブ内にクラッド形成ガスを通 して垓石英系ガラスチューブ内面にクラッド層

ァイバ母材の製造においては、大サイズの母材をうることが比較的容易であり、かつ寸法精度が高いというRT法の長所がそのまま生かされるので、本発明によれば低失の光ファイバを効率よく、かつ高い歩留りで比較的容易に製造することが可能となり、したがって本発明の光ファイバ母材の製造方法は低損失光ファイバの量産技術として優れたものである。

[実施例]

本発明において用いられる石英系ガラスチューブはえられる光ファイバ母材のサポートを形成するものである。

この石英系ガラスチューブを回転させながら、 外部よりパーナで加熱し、該石英系ガラスチュ ープ内にクラッド層形成ガスを通してクラッド 層が形成される。

ガラス原料ガスとしては、Si H4、Si H2 C1、Si H2 C1 2、 SI H1 C1 3、 Si C1 4、 Si H3 Br、Si H2 Br 2、 SI H1 Br 3、 Si Br 4、 Si H3 I、Si H2 I 2、 Si H1 3、 SI H4、 Si H3(OCH 3)、Si H2(OCH 3)2、 Si H(OCH 3)3、 Si (OCH 3)4 などのシラン化合物または気化性のシラン誘導体など、またドーパントノースガスとしては、フッ葉をドープするばあいには CC1 3 F、 CC1 2 F2、

のち純水清浄するなどの方法により表面が清浄 にしたものが好ましい。それら処理、洗浄の際 には超音波による洗浄を併用してもよい。

上記石英系ガラスチュープ内にクラッド形成ガスを通しての加熱は、通常該石英系ガラスチューブ外面を酸水素パーナなどのパーナにより該ガラスチュープ内面にクラッド層を形成せしめるために1400~1900℃、なかんづく1500~1700℃に加熱するのが好ましい。

なお、石英系ガラスチューブ内にクラッド層を均一に形成させるためには、該ガラスチューブを適度に回転させるとともにパーナを該ガラスチューブ方向に適宜往復移動させるのが好ましい。

該ガラスチューブの加熱方法の一例としては、 ガラスロッドを回転させながら、酸水素パーナ などの加熱顔を前記ガラスロッドと平行にゆっ くり往復または反復移動させつつ加熱する方法 があげられる。この加熱顔を移動する加熱方式 は、本発明においてはとくに好ましいものであ CCI F₃、 CF₄ などのフレオン類、 CI F 、 CI F₃、 BFなどのフレオン相互の化合物、 SF₆ 、 F₂、 F₁ O 、 Si F₄ などが、またホウ茶をドープするばあいには、 BH₃ 、 BH₂ CI 、 BCl₃ 、 BH₂ Br、 BBr₃ 、 BH₂ I 、 BII 2 、 BI₃ などのポランまたは気化性のボラン誘導体が用いられる。

また本発明において、フッ素とホウ素がドープされた St. O2 のスートを形成せしめるために用いるドーパントソースガスとしては、上記のフッ素化合物ガスおよびホウ素化合物ガスを同時に用いてもよいが、フッ素とホウが同時にスート中にドープされるためには、ドーパントソースガスとしては BF』を用いるのが好ましい。

またドーパントソースガスには、さらにチッ 素、アルゴン、ヘリウム、酸素、水素などの他 のガスを混合してもよい。

上記クラッド形成ガスは石英系ガラスチューブに導入されるが、該石英系ガラスチューブは、 散乱損失の一段と少ない光ファイバを製造する ために、前もってフッ酸水溶液などで処理した

って、そのばあい 加熱 源の移動 速度 は約 10~500 mm / 分、なかんづく約 100~200 mm / 分程度が好ましい。

かくして石英系ガラスチューブ内にクラッド 層が形成されるが、該クラッド層の厚さはえられる光ファイバ母材の用途などによって異なる ので一概には決定することはできないが、通常 0.5 ~ 3 mm となるように調整される。

本発明に用いられる石英系ガラスロッドはえられる光ファイバ母材のコアを形成するものである。

この石灰系ガラスロッドとしては、Cu、Fa、Co、Crなどのような光伝送損失を大とならしめるような不純物の含有率が、たとえば10ppa 以下の通常使用されている石英ガラスを使用しうる。

なお、この石英系ガラスロッドには、散乱損失の一段と少ない光ファイバを製造するために、前もって上記石英ガラスチューブを洗浄するのと同様にして清浄にしたものが好ましい。

つぎにクラッド層が形成された石英系ガラス チューブ内に石英系ガラスロッドを挿入設置し たのち、該ガラスチューブとガラスロッドとの 間隙にのちに詳記するガラス表面変性処理ガス を流しながら、該ガラスロッド外表面を加熱す ることにより、抜ガラスロッドの表面と抜ガラ スチュープ内に形成されたクラッド層表面の変 性処理をする。この変性処理は低温で行なうと 変性が不充分となり、本発明の目的が達成され ないので、少なくとも1000で、好ましくは少な くとも1200℃、より好ましくは少なくとも1400 ての温度で行なうのがよい。ここで変性処理温 度はチューブの外表面の温度を表わす。前記温 皮以上の高温度で変性処理をおこなってもさし つかえないが、使用するガラスロッド、ガラス チューブあるいはガラスチューブ内に形成され たクラッド層の種類によっては、それらの分布 などが大きく変化することがあるので、2000で 以下の温度で行なうのが好ましい。

前記ガラスロッドとガラスチューブの加熱は

にとりこまれることがなくなり、そのOH基による吸収損失が小さくなるので、低損失の光ファイバをうることができる。用いるガラス表面変性処理ガスの塩素含有率が高いほど前記OH基による吸収損失が小さいので、本発明で用いるガラス表面処理ガスとしては塩素含有率が80容量%以上のものが好ましい。

前記ガラス表面変性処理ガスの塩素以外のガス成分としては、アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガス、酸素があげられるが、これらの不活性ガスや酸素は、ガラス表面変性処理ガスのおれば、ガラス表面変性処理ガスやに 20容量 %未満含有されるのであれば不活性ガスおよび酸素の組成比はいかなるものであってもよい。

本発明においては、ガラスロッドおよびクラッド層が形成されたガラスチューブ内面のごく 表面層を変性するのみで充分な効果がある。変 性処理に要する時間はガラス表面変性処理ガス 中の塩素濃度、ガラス表面変性処理ガスの全圧、

本発明に用いるガラス表面変性処理ガスは、 塩素を80容量%以上含有するものである。

ガラス表面変性処理ガスとして塩素含有率が 80容量%以上のものを用いると、変性処理の際 にOH基がガラスロッドとガラスチューブの表面

液量などによって変化し、塩素濃度が高く、含化し、塩素濃度が高くにあるが、ガラス表面変性処理ガスの全圧が 500~2000ml/分、ガラス表面変性処理が 80容量 2000ml/分、ガラス専動を性処理が 80容量 2000 を移動 2000 を移動 2000 を移動 2000 を変更 200

前述のごとくに変性処理したガラスはなる。 ガラスチューがは常にしたがって行なる。 くの融着したがって行っているとがったがったがある。 くのではガラスサーをがっているのではガラスをでいる。 を立っているではガラスをではから、ではから、ではからないではからないではからないではからないではないではない。 ラスチューナの外表を1900~2300ではでから、 カーナの格性でガラスチューで発明 における光ファイバ母材がえられる。 本発明の製造方法により製造された光ファイバ母材からの光ファイバの製造は常法にしたがって行なえばよく、たとえば光ファイバ母材を選扱炉などで2000~2300℃程度に加熱しながら、10~ 100m / 分程度の速度で線引きし、外径100 ~ 200m 程度のファイバとする。

つぎに本発明の光ファイバ母材の製造方法を 実施例および比較例をあげて説明するが、本発 明はかかる実施例のみに限定されるものではない。

実施例1~4および比較例1~3

表面が清浄された石英ガラスチューブ(内径 24 ma)を 60 rpm の速度で回転させながら、外部より酸水素パーナで約 1600 C に加熱したクラッド形成ガスを第1表に示されるように調整して所定の時間順次通しガラスチューブ内面にクラッド層を形成させた。

ついで表面が清浄された純石英ガラスロッド (直径 8 ma) を該クラッド層つきチューブ内に 挿入し、第1表に示されるように調整されたガ

125 畑の光ファイパをえた。

えられた光ファイバの物性として波長 1.3 mmにおける光伝送損失および光ファイバ中における 0H基合有温度を求めた。その結果を第 1 表に併記する。

[以下杂白]

ラス表面変性処理ガスをガラス ロッドとの間隙に連続供給し、ガラスチューブを中心軸のまわりに 60 rpm で同期回転させながら、ガラスチューブの外面を、酸水素パーナを用いて 100mm / 分ので で で なっ ドとガラスチューブ に 20 仮復移動 し て 変性処理 ステューブに 10回反復移動 し て 変性処理 を行なった。酸水素パーナで加熱 は 混度 計で別をのチューブ外表面の温度は赤外線温度計で別定したころ、約1600であった。

前記変性処理ののち直ちにガラスロッドとガラスチューブをひきつづき中心軸のまわりに 60 rpm の速度で同期回転させなから、酸水素バーナでガラスチューブを 2200℃に 加熱して 潰し、ガラスロッドとガラスチューブとを 融着一体化させてさらに石英管を被覆し外径 20 mm の光ファイバ母材をえた。

前記のごとくえられた光ファイバ母材をカーボン抵抗炉により 2200 でに加熱しながら 40 m / 分の速度で線引きし、コア径 50μm、クラッド径

第 1 表

		クラッド形成ガスの流量(cc/分)					ガラス表面変性処理ガスの 組成(容量%)				
実施例	1									物性	
番号	}	SICIA	BF3	02	BCA 3	SIF4	CA 2	λr	02	光伝送損失	011基含有
										(dB/km)	漫度 (ppb)
1		300	250	800	_	-	100	6	0	0.8	50
2		300	-	900	- 100	250	90	10	0	0.8	50
3		300	250	800	-	-	8.0	0	20	0.8	70
4		300	250	800	_	_	80	0.1	10	0.8	. 70
比較例1		300	250	800	_	_	70	Q	30	1.5	200
2		300	250	800		_	50	G	50	2.0	1000
3		300	250	800	_	_	10	G	90	7.4	5000

[発明の効果]

本発明の製造方法によれば、ガラス表面変性 処理ガスに含有される塩素適度が 80容量 %以上であっても光の散乱損失が小さく、光の伝送損失がの高い歩ない光ファイバ母材を効率よく、かつ高い歩留りで比較的容易に製造することができるので、本発明の光ファイバ母材の 製造方法は、低損失光ファイバの量度技術として優れたものである。

特許出願人 大日日本選線株式会社 代理人弁理士 朝日奈 宗太 ほか1名 宗列解 (おの)選